

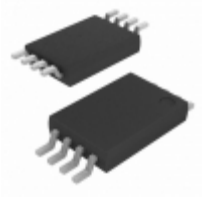







	DMN2016LHAB-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2016LHAB-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 6UDFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2016LHAB-7.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 216600 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2016LHAB-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 6UDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	216600 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.2W
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2030-6
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.5 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1550pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2016LHAB-7 ist neu im Original, Suche DMN2016LHAB-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2016LHAB-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2016LHAB-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2019UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.4A TSSOP-8</p>	 <p>DMN2016UTS D D TSSOP-8</p>	 <p>DMN2017UFDE-7 DIODES DMN2017UFDE-7 DIODES</p>	 <p>DMN2015UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 15.2A UDFN2020-6</p>
 <p>DMN2015UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 15.2A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN2015UFDE.TCT SEMTECH DMN2015UFDE.TCT SEMTECH</p>	 <p>DMN2016UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8- TSSOP</p>	 <p>DMN2015UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10.5A U- DFN</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  DMN2004DWK-7 |  DMN2004DWK-7-F |  DMN2004K-7 |  DMN2004K-7-F |  DMN2004TK-7 |
|  DMN2004TK-7-F |  DMN2004VK |  DMN2004VK-7 |  DMN2004VK-7-G |  DMN2004WK-7 |
|  DMN2004WKQ-7 |  DMN2005DLP4K-7 |  DMN2005K-7 |  DMN2005K-7-F |  DMN2005LP4K-7 |
|  DMN2005LPK-7 |  DMN2009LSS |  DMN2009LSS-13 |  DMN2009LSS-13-F |  DMN2011UFX-7 |
|  DMN2013UFDE-7 |  DMN2013UFDEQ-7 |  DMN2015UFDE-7 |  DMN2015UFDE.TCT |  DMN2016LFG-7 |
|  DMN2016UTS-13 |  DMN2017UFDE-7 |  DMN2019UTS-13 |  DMN2020LSN |  DMN2020LSN-7 |
|  DMN2020LSN-7-F |  DMN2020UFCL-7 |  DMN2023LSD-13 |  DMN2026UVT-7 |  DMN2027LK3-13 |
|  DMN2027USS |  DMN2027USS-13 |  DMN2027USS-13-F |  DMN2028UFDH-7 |  DMN2028USS |
|  DMN2028USS-13 |  DMN2028USS-13-F |  DMN2028UVT-7 |  DMN2029USD |  DMN2029USD-13 |
|  DMN2040DTS-13 |  DMN2040LSD-13 |  DMN2040LSS-13 |  DMN2040LTS |  DMN2040LTS-13 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited